SMILE44:長期気球実験に向けた MPPCシンチレーションカメラの 性能評価

京都大学 齋藤要

谷森達,高田淳史,水村好貴,古村翔太郎,岸本哲朗,竹村泰斗,吉川慶,中増勇真, 中村優太,谷口幹幸,小野坂健,阿部光,水本哲矢,園田真也,窪秀利

黑澤俊介(東北大NICHe、山形大理),身内賢太朗(神戸大理) 澤野達哉(金沢大数物)

目次 開発中のシステムについて 性能評価

- ・エネルギー分解能
- ・時間分解能 温度補償について



次期 長期気球実験 SMILE-3

SMILE-3

南半球Super Pressure Balloon 観測時間: ~ | ヶ月

<u>COMPTELの5倍の感度で</u>半球のサーベイ 3.7 W/PSA → < 0.1 W/PSA

- ・銀河面に広がる²⁶AI
- ・電子陽電子対消滅線の銀河面分布
- ・GRBの 偏光観測 など

SMILE-2+





Pixel Scintillator Array

求められる性能

- ・省電力
- ・ゲインの安定性
- ・広いダイナミックレンジ
- 0.2-3 MeV → 0.3-6 MeV





・省電力 ・ゲインの安定性





MPPC & AMP & Peak Hold ADC

△E/E ~9% @662 keV
SMILE-2+ (GSO & PMT & Peak Hold ADC)
△E/E ~11% @662 keV (2016.3 JPS 中增講演)

Peak Hold ADC → Sampling ADC TPCトリガーによるデッドタイム削減 (2016.3 JPS 吉川講演)

MPPC & AMP & <u>Sampling ADC</u> & FPGA



△E/E ~ 10.7% @662 keV (ADC-部破損) (2017.9 JPS 齋藤講演)
本講演 ↓^{修理}

MPPC & AMP & Sampling ADC & FPGA

- ・エネルギー分解能
- ·時間分解能
- ・温度補償について



FPGA基板 (version 3)



3.3 V

FPGA基板

ADC基板



①データ収集・通信
 ②回路(ADC)の制御
 ③温度計
 ④各基板へ電源供給

version I → 3 低ノイズDC/DCに変更 電源ラインのノイズの低減

~20 mV

 $\sim 100 \text{ mV}$





時間分解能







浜松ホトニクス



オーバー電圧を一定に保つように温度に応じて動作電圧を変化させることで 温度特性を打ち消すことができると思われる

まとめと今後



次期計画:長期気球実験 SMILE-3 に向けて MPPCシンチレーションカメラの開発を進めている

(GSO + MPPC) ピクセル間ゲイン補正により エネルギー分解能 7.8% @662 keV にまで向上

時間分解能 要求値 20 nsに対して ~50 ns →2.5 MHzから4.5 MHzへ変更を検討

MPPCの温度補償 →FPGA基板に搭載の温度計とDC/HVを用いて オーバー電圧を一定に保つことで <u>MPPCの温度特性</u>を打ち消す 0.24 V/℃





MPPC ゲイン補正②

 $137 \operatorname{cr} \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A}$



_			•	-			
8765 	9525	10394	10308	10294	9731	9367	9060
10531	10139	9819	9736	9777	9995	9997	9406
_ _ 9759 _	10721	10813	10516	9888	10405	10185	9727
9697 	9870	10388	10107	9829	10161	9585	9106
 10018 	10599	10413	10588	10212	10431	10185	9855
 10058 	10371	10555	10503	10473	10724	10401	9874
 9868 	10060	10227	10291	9884	10399	10205	9633
 8665	9757	10197	9860	9368	9622	9726	9349

ゲイン(相対値)のばらつき

基準:10000

ダイナミックレンジ①











¹³⁷Cs 662 keVピークの出力電荷







Multi-Pixel Photon Counter



電子雪崩を利用した光子計測半導体素子





S	13361-3050N	E−08 (25℃
	有感波長領域	320 - 900 nm
	光子検出効率	40 %
	ゲイン	1.7×10^{6}
	端子間容量	320 pF
	降伏電圧(V _{BD})	53 ± 5 V
	推奨動作電圧	V _{BD} + 3 V